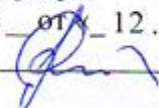



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Утверждено:
на заседании кафедры
протокол № 4 от 12.01.2022 г.
Зав. кафедрой  / Салихов Р.Б.

Согласовано:
Председатель УМК ФТИ
 / Балапанов М.Х.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

дисциплина **ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ И КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА**
(наименование дисциплины)

Обязательная часть

(указать часть (обязательная часть или часть, формируемая участниками образовательных отношений))

программа бакалавриата

Направление подготовки (специальность)

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
квалификация (степень) бакалавр

(указывается код и наименование направления подготовки (специальности))

Направленность (профиль) подготовки

Оптические системы и сети связи


(указывается наименование направленности (профиля) подготовки)

Квалификация

Бакалавр

(указывается квалификация)

Разработчик (составитель)
к.ф.-м.н., доцент Шакиров Б.Г.
(должность, ученая степень, ученое звание)

 / Шакиров Б.Г.
(подпись, Фамилия И.О.)


Для приема 2020 г.

Уфа 2022 г.

Составитель: Шакиров Б.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и нанoeлектроники

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры инфокоммуникационных технологий и нанoeлектроники №4 от 12.01. 2022 г.

Заведующий кафедрой



/ Салихов Р.Б./

Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)
4. Фонд оценочных средств по дисциплине
 - 4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
 - 4.3. *Рейтинг-план дисциплины (при необходимости)*
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
 - 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(с ориентацией на карты компетенций)

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Категория (группа) компетенций	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
Системное и критическое мышление	ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности	<p>ОПК-1.1. Знать физические принципы действия приборов квантовой и оптоэлектроники; устройство и характеристики излучения твердотельных, газовых и полупроводниковых лазеров; приемников оптического излучения;</p> <p>ОПК-1.2. Уметь выполнять экспериментальные исследования на установках с различными типами лазеров, проводить юстировку и измерения параметров их выходного излучения</p> <p>ОПК-1.3. Владеть научно-технической информацией о состоянии квантовой и оптоэлектроники и устройств, основанных на эффектах нелинейной оптики и перспективах использования результатов теоретических и экспериментальных</p>	<p>Знать физические принципы действия, устройства оптических квантовых усилителей и генераторов и оптоэлектронных приборов; характеристики и параметры излучения различных типов лазеров и полупроводниковых фотоприемников.</p> <p>Уметь выполнять экспериментальные исследования установках различными типами приборов квантовой электроники, проводить настройку и определения основных параметров.</p> <p>Владеть научно-технической информацией о развитии квантовой и оптической электроники, нелинейно-оптических устройств перспективах использования результатов теоретических и экспериментальных исследований в оптических системах и сетях связи.</p>

		исследований в оптических системах и сетях связи	
	ОПК-2. Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных	ОПК-2.1. Знать нелинейные оптические эффекты при распространении лазерного излучения в оптической среде; терминологию, определения, обозначения и единицы измерения характеристик квантовых и оптоэлектронных приборов. ОПК-2.2. Уметь проводить расчеты и компьютерное моделирование различных режимов генерации лазеров. ОПК-2.3. Владеть навыками работы с контрольно-измерительными приборами в соответствии требованиям технических регламентов.	Знать нелинейные оптические эффекты, обусловленные воздействием интенсивного лазерного излучения оптически анизотропные среды, терминологию, определения, обозначения и единицы измерения характеристик квантовой и оптической электроники. Уметь проводить расчеты и компьютерное моделирование различных режимов генерации лазеров. Владеть навыками работы с контрольно-измерительными приборами в соответствии требованиям технических регламентов.

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства» относится к обязательной части и входит в раздел «Б1.О.30» (профессиональный цикл) ФГОС по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии системы связи». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-м семестре.

Целью преподавания дисциплины: формирование современных представлений о физических принципах действия, конструкции и характеристиками квантовых и оптоэлектронных приборов и устройств и приобретение ими следующих компетенций: готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; способность проводить экспериментальные исследования и инструментальные измерения на лазерных установках с использованием оптоэлектронных устройств; знание возможностей применения оптоэлектронных и квантовых приборов и устройств для создания новых перспективных средств электро- и оптической связи.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении дисциплин: Электричество и магнетизм; Волновая и квантовая оптика, Квантовая физика, Физические основы электроники, Электромагнитные поля и волны.

Данная дисциплина призвана также обеспечить обучающихся знаниями и навыками, необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, а также является фундаментом для успешного освоения программ ряда учебных дисциплин профиля подготовки «Оптические системы и сети связи», таких как Источники и приемники оптического излучения, Оптические направляющие среды и др.

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении №1

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код и формулировка компетенции:

ОПК-1. Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Экзамен:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Неудовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
ОПК-1.1. Знать: Физические принципы действия лазеров: вынужденное излучение, инверсия населенности и квантовых уровней и методы ее получения, положительная обратная связь (оптический резонатор).	Знать: физические принципы действия твердотельных, газовых, полупроводниковых лазеров, устройство и режимы работы, параметры выходного излучения лазера.	Ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и неполном знании основных понятий и материала включенных в рабочую программу, не смог ответить ни на один дополнительный вопрос	При ответе на теоретические вопросы допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Теоретические вопросы в целом изложены доста-	В ответе в целом раскрыты теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий и в ответе на дополнительные вопросы	Ответ является полным, развернутым по всем теоретическим вопросам, знает терминологию и дополнительные вопросы.

			точно,но с про-пусками части материала.		
ОПК-1.2. Уметь: -применять теоретические знания при выполнении лабо-раторных работ	Уметь: -применять теоретические знания при выполнении лабо-раторных работ	Не готовился к выполнению лабораторной работы, не знает теорию	Поверхностно ознакомился с описанием лабораторной работы и теорией	Готов к выполнению лабораторной работы, в целом знает теорию	Готов к выполнению лабораторной работы, знает теорию
ОПК-1.3. Владеть: -научно-технической информацией по тематике исследования из учебных пособий, справоч-ников, ресурсов сети «Интернет»	Владеть: -научно-технической информацией по тематике исследования из учебных пособий, справоч-ников, ресурсов сети «Интернет»	Не владеет научно-технической информацией по тематике исследования	Частично владеет научно - техн.информацией по тематике исследования	В основном владеет научно-технической информацией по тематике исследования	Владеет научно-технической информацией по тематике исследования

Код и формулировка компетенции

ОПК-2. Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных

Экзамен

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Неудовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
ОПК-2.1. Знать: элементную базу лазерной техники (активные вещества, зеркала, лампы накачки); устройства электропитания и управления, аппаратуру для измерения параметров лазерного излучения	Знать: элементную базу лазерной техники (активные вещества, зеркала, лампы накачки); устройства электропитания и управления, аппаратуру для измерения параметров лазерного излучения	Практически не знает элементную базу лазерной техники, устройства электропитания и управления, измерительную аппаратуру	Знает частично элементную базу лазерной техники, устройства электропитания и управления, измерительную аппаратуру	Знает в целом элементную базу лазерной техники, устройства электропитания и управления, измерительную аппаратуру	Знает элементную базу лазерной техники, устройства электропитания и управления, измерительную аппаратуру

ОПК-2.2. Уметь: применять теоретические знания при вы- полнении лабо- раторных работ обрабатывать результаты из- мерений	Уметь: применять теоретические знания при вы- полнении лабо- раторных работ, обрабатывать результаты из- мерений	Не готов к применению теоретичес- ких знаний при выполне- нии лабора- торных работ, не умеет об- рабатывать результаты измерений	Частично го- тов к приме- нению теоре- тических зна- ний при выпол- нении лабора- торных работ, умеет обраба-тывать результаты изме-рений	В целом готов к при- менению теоретичес- ких знаний при выпол- нении лабо- раторных работ,умеет обрабаты- вать рез-ты измерений	Готов к примене- нию теоре- тических знаний при выполнении лаборатор- ных работ, умеет обра- батывать результаты измерений
ОПК-2.3. Владеть: -методикой составления научно-техни- ческого отчета -навыками ана- лиза результа- тов теретичес- ких и экспе- риментальных исследований	Владеть: методикой составления научно-техни- ческого отчета, навыками ана- лиза результа- тов теретичес- ких и экспе- риментальных исследований	Не владеет методикой составления научно-техн. отчета и на- выками ана- лиза резуль- татов терети- ческих и экс- перименталь- ных иссле- дований	Частично владеет методикой составления научно- технич. отчета и на- выками анали- за результа- тов теоретических и эксперимен- тальных иссле- дований	В целом владеет ме- тодикой со- ставления н.техн.отче- та и навы- ками анали- за результа- тов теоре- тических и эксперимент альных ис- следований	Владеет методикой составления научно- техн. отчета и навыками анализа ре- зультатов теретичес- ких и экспе- рименталь- ных иссле- дований

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины (для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль – максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10) и за ответы обучаемого на экзамене-максимум 30 баллов.

Шкалы оценивания

Для экзамена: от 0 до 44 баллов- «неудовлетворительно»
от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»;
от 60 до 79 баллов – «хорошо»;
от 80 до 110 баллов – «отлично».

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
--	-----------------------------------	--------------------

<p>ОПК-1</p> <p>Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности</p>	<p>ОПК-1.1.</p> <p>Знать физические принципы действия лазеров и приборов оптоэлектроники; устройство твердотельных, газовых и полупроводниковых лазеров; методы управления параметрами лазерного излучения;</p>	<p>Письменный опрос, экзамен</p>
	<p>ОПК-1.2.</p> <p>Уметь выполнять исследования на экспериментальных установках с различными типами лазеров, проводить юстировку и измерение параметров их выходного излучения</p>	
	<p>ОПК-1.3.</p> <p>Владеть научно-технической информацией о современном состоянии и перспективах развития квантовой электроники, оптоэлектроники и устройств, основанных на эффектах нелинейной оптики и возможностях использования результатов этих исследований в устройствах сетей оптической связи</p>	
<p>ОПК-2</p> <p>Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных</p>	<p>ОПК-2.1.</p> <p>Знать нелинейные оптические эффекты при распространении лазерного излучения в среде; терминологию, определения, обозначения и единицы измерения характеристик квантовых и оптоэлектронных приборов</p>	<p>Письменный опрос, экзамен</p>
	<p>ОПК-2.2.</p> <p>Уметь выполнять расчеты и компьютерное моделирование различных режимов генерации лазеров; обрабатывать результаты экспериментальных измерений</p>	
	<p>ОПК-2.3.</p> <p>Владеть навыками экспериментального исследования характеристик квантовых и оптоэлектронных приборов в рамках физического и математического моделирования.</p>	

4.3. Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг-план дисциплины представлен в приложении №2.

Экзаменационные билеты

Структура экзаменационного билета

Билет состоит из трех вопросов:

- 1) учебный материал, относящийся к 1-му модулю курса (принципы действия лазера);*
- 2) учебный материал, относящийся к 2-му модулю курса (устройство лазеров различных типов, режимы работы лазера);*
- 3) параметры лазерного излучения, вопросы нелинейной оптики, оптоэлектронные устройства.*

Примерные вопросы для экзамена

1. Квантовые свойства вещества. Населенности квантовых уровней. Распределение населенностей по уровням в условиях термодинамического равновесия (формула Больцмана).
2. Световая волна и ее характеристики. Поток, плотность потока энергии электромагнитной волны (света), их размерности. Вектор Пойнтинга. Что определяет модуль вектора Пойнтинга?
Интенсивность света, плотность потока фотонов.
3. Взаимодействие света с веществом, спонтанные и индуцированные переходы в квантовых системах. Вероятности квантовых переходов. Коэффициенты Эйнштейна.
4. Резонансное поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения, их свойства. Нарисуйте схему «размножения» фотонов при вынужденных переходах
5. Связь между коэффициентами Эйнштейна B_{21} и B_{12} , A_{21} и B_{21} (термодинамическое рассмотрение).
6. Закон убывания населенности квантового уровня вследствие спонтанных переходов. Время жизни атома на верхнем уровне, его связь с вероятностью перехода. Излучательные и безызлучательные квантовые переходы.
Мощность спонтанного излучения (формула, график)
7. Основы теории формы и ширины линии излучения. Функция формы линии излучения, ширина линии излучения
8. Естественная ширина линии излучения (оценка из соотношения неопределенностей Гейзенберга). Лоренцева форма линии излучения. Другие факторы уширения линии излучения.
9. Физические принципы, лежащие в основе действия квантового усилителя. Схема линейного оптического квантового усилителя.
Формула для интенсивности света в двухуровневой усиливающей среде. Графики изменения интенсивности в среде (при различных соотношениях населенностей) Коэффициент квантового усиления. Сечение квантового перехода
10. Физические принципы, лежащие в основе работы лазера. Оптическая схема устройства лазера. Принцип обратной связи в лазерах. Условие самовозбуждения лазера.
11. Инверсия населенностей квантовых уровней. Понятие отрицательной температуры. Методы получения состояния вещества с инверсией населенностей квантовых уровней
12. Метод вспомогательного излучения в оптическом диапазоне. Трех- и четырех-уровневые схемы накачки. Их сравнение.
13. Анализ трехуровневой схемы накачки для оптического диапазона. Кинетические

уравнения. Условие получения инверсии населенностей.

14. Открытые резонаторы, их назначение. Параметры ОР. Добротность ОР.

15. Классификация открытых резонаторов.

16. Условие устойчивости открытого резонатора (основы геометрической теории).

17. Волновая теория открытого резонатора. Спектр продольных и поперечных типов колебаний (мод) открытого резонатора

18. Твердотельные лазеры.. Устройство и принцип действия.

19. Элементы твердотельных лазеров: активные вещества, лампы накачки, зеркала.

20. Схема электропитания твердотельных лазеров.

21. Лазер на рубине. Устройство, схема энергетических уровней. Основные характеристики выходного излучения

22. Неодимовые лазеры. Обобщенная схема энергетических уровней. Основные характеристики выходного излучения.

23. Анализ работы твердотельного лазера в режиме свободной генерации.

24. Анализ работы твердотельного лазера в режиме модулированной добротности.

25. Методы модуляции добротности резонатора лазера: оптико-механический; электрооптический; с насыщающимся красителем.

26. Твердотельный лазер с электрооптической модуляцией добротности.

27. Твердотельный лазер в режиме синхронизации мод.

Методы синхронизации, характеристики выходного излучения.

28. Газовые лазеры. Общая характеристика. Типы газовых лазеров. Устройство, принцип действия.

29. Механизмы получения инверсии населенностей в плазме газового разряда в газовых лазерах.

30. He-Ne лазер. Конструкция, схема энергетических уровней, характеристики излучения

31. Энергетические состояния в полупроводниках. Графики зависимости энергии электронов и дырок в зоне проводимости и в валентной зоне в параболическом приближении. Условие квантового усиления электромагнитной волны (света) в полупроводнике.

32. Принцип действия лазерного диода на p-n переходе полупроводника.

33. Полупроводниковый лазер на арсениде галлия на гомопереходе. Конструкция, основные характеристики и параметры лазерного излучения. Основной недостаток лазера на гомопереходе.

34. Полупроводниковый лазер на арсениде галлия на гетеропереходе. Конструкция, основные характеристики и преимущества такого лазера.

35. Свойства лазерного излучения: когерентность, монохроматичность, расходимость, их количественное описание. Энергетические характеристики лазерного излучения.

36. Формирование спектра и поперечной структуры излучения лазера. Селекция продольных и поперечных мод.

37. Взаимодействие светового излучения с веществом. Сравнение величин напряженностей электрического поля классических и лазерных источников с напряженностью поля в атоме. Линейная и нелинейная поляризации вещества. Нелинейные оптические эффекты.

38. Генерация второй оптической гармоники в нелинейных кристаллах. Когерентная длина. Эксперимент по получению второй гармоники излучения лазера на рубине в кристалле кварца.

39. Способ увеличения когерентной длины в анизотропном кристалле. Направление синхронизма.

40. Кубическая нелинейность вещества. Самофокусировка света.

41. Принцип работы полупроводниковых фотоприемников. Внутренний фотоэффект.

Фотопроводимость.

42. Характеристики и параметры фотоприемников.

Фотодиод. Принцип действия, схемы включения, вольт-амперная характеристика.

Образец экзаменационного билета:
Приведен в приложении №3

В рамках использования модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости студентов итоговая оценка знаний студента по дисциплине производится по сумме баллов, полученных при прохождении текущего и рубежного контроля знаний, умений и навыков в течение семестра, и баллов, полученных на экзамене.

За работу в семестре студент может набрать до 70 баллов за выполнение заданий в рамках текущего и рубежного контроля и дополнительно до 10 баллов за результаты участия в олимпиаде или студенческой научной конференции. Для допуска к экзамену студент должен набрать в семестре не менее 35 баллов.

Максимальное количество баллов, получаемое студентом на экзамене, составляет 30.

Перевод оценки из 100-балльной в пятибалльную производится следующим образом:

- отлично –от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- хорошо -от 60 до 79 баллов;
- удовлетворительно-от 45 до 59 баллов
- неудовлетворительно –менее 45 баллов

Критерии оценки (в баллах):

- **25-30 баллов** выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы.

- **17-24 баллов** выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности.

- **10-16 баллов** выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками части материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос.

- **1-10 баллов** выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос/

Критерии оценки для заочной форме обучения:

- **отлично** выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы.

- **хорошо** выставляется студенту, если студент раскрыл в основном вопросы билета, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности.

- **удовлетворительно** выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Ответы на вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос.

- неудовлетворительно выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Темы лабораторных работ

Лабораторная работа №1 Компьютерное моделирование режима работы твердотельного лазера

Лабораторная работа № 2 Лазер на кристалле ИАГ: Nd^{+3} в режиме свободной генерации

Лабораторная работа №3 Лазер на кристалле ИАГ: Nd^{+3} в режиме модуляции добротности

Лабораторная работа № 4 Полупроводниковый лазер

Лабораторная работа № 5 Электрооптические модуляторы светового излучения

Лабораторная работа № 6 Лазерный доплеровский измеритель скорости частиц

Лабораторные работы описаны в методичке:

«Оптоэлектронные и квантовые приборы. Методические указания по выполнению лабораторных работ» - Уфа: РИО БашГУ, 2012.

Пособие размещено на сайте Электронно-библиотечной системы Башкирского государственного университета «Университетская библиотека online» <http://www/biblioklub.ru/>

Порядок выполнения, требования к оформлению отчета и контрольные вопросы для сдачи отчета имеются в описании каждой лабораторной работы.

Комплект тестов (тестовых заданий)

по дисциплине «Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства»

Текущий и рубежный контроль знаний обучающихся проводится в соответствии с рейтингом-планом учебной дисциплины.

Текущий контроль

1. Контроль за посещением и выполнением лабораторных работ в практикуме, проверка и прием отчетов.
2. Тестирование на знание физических принципов действия лазера.

Критерии оценки одной лабораторной работы (в баллах)

Выполнение работы	3 балла,
Представление оформленного отчета	2 балла,
Даны правильные ответы на все контрольные вопросы	2 балла.

Рубежный контроль

реализуется путем проведения письменного тестирования:

- после изучения учебного материала 1-го модуля курса;
- после изучения учебного материала 2-го модуля курса.

Пример варианта тестового задания на знание принципов действия лазера

1. а) Из табл. выберите физические явления, связанные с принципами действия оптического квантового усилителя (ОКУ).

Спонтанное излучение (а)	Вынужденное излучение (б)	Резонансное поглощение (в)	Инверсия населенностей квантовых уровней (г)	Положительная обратная связь (д)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------

б) Нарисуйте схему ОКУ

2. Населенность квантового уровня N – это:

- а) число частиц, находящихся на самом верхнем уровне, отнесенное к единице объема вещества;
 - б) число частиц, находящихся на самом нижнем уровне, отнесенное к единице объема вещества;
 - в) число частиц, находящихся на данном уровне, отнесенное к единице объема вещества
 - г) общее число частиц, находящихся на всех уровнях, отнесенное к единице объема вещества.
- Правильный ответ обвести кружочком

3. Напишите формулы, связывающие:

- а) коэффициенты Эйнштейна B_{12}, B_{21} и A_{21}, B_{12}, B_{21} ;
- б) вероятности вынужденного излучения W_{21} и вероятности поглощения W_{12}
- в) полные вероятности переходов со второго уровня на первый и с первого на второй

4. Покажите процессы квантовых переходов в двухуровневой квантовой системе, одержащей один электрон: а) спонтанные переходы и спонтанное излучение; б) резонансное поглощение; в) вынужденные переходы и вынужденное излучение. Введите вероятности соответствующих переходов. Перечислите свойства спонтанного излучения и вынужденного излучения.

5. Нарисуйте обобщенную схему автогенератора, т.е. устройства, вырабатывающего незатухающие электромагнитные колебания. Положительная и отрицательная обратная связь. За счет какого устройства реализуется положительная обратная связь в лазере и почему она является положительной?

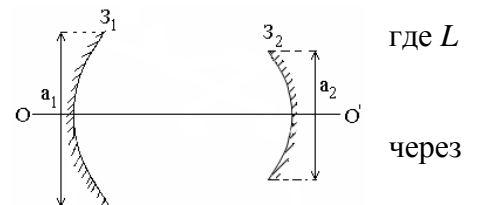
Критерии оценки тестового задания

Правильный ответ на один вопрос оценивается в 1 балл.

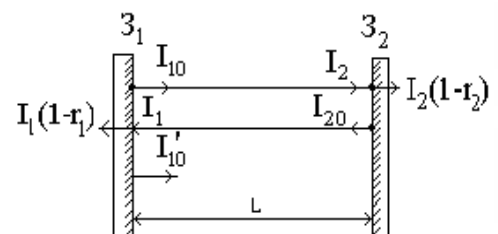
Пример варианта тестового задания по учебному материалу 1-го модуля курса

1. На рис. представлена схема устойчивого сферического открытого резонатора (ОР), т.е. выполняется условие $L \leq R_1 + R_2$, – база резонатора, R_1, R_2 – радиусы кривизны зеркал.

- а). нарисуйте на схеме величины L, R_1, R_2 ;
- б). напишите формулу, определяющую условие устойчивости ОР g-параметры;
- в) нарисуйте диаграмму устойчивости ОР и покажите на ней точки, соответствующие: плоскопараллельному, конфокальному и полуконфокальному резонатору. Какой из этих резонаторов не критичен к разъюстировке зеркал резонатора?



2. Рассмотрите процесс квантового усиления



интенсивности световой волны в открытом резонаторе с базой L , состоящего из двух зеркал с коэффициентами отражения Γ_1 и Γ_2 соответственно.

Напишите формулы для значений интенсивности света

I_{20} , I_1 , I_{20} и I_{10}' за один обход резонатора в процессе квантового усиления световой волны при заданном I_{10} .

Чему равно критическое значение коэффициента квантового усиления $G_{кр}$?

3. На рисунке приведены трехуровневая (а) и четырехуровневая (б) схемы оптической накачки лазера (N_i - населенности уровней, $i=1,2,3,4$) под действием излучения накачки с частотой $\nu_{нак}$.



1). нарисуйте схемы квантовых переходов, соответственно, для рис. (а) и для рис. (б)

2). что понимается под инверсной населенностью Δ и между какими уровнями реализуется инверсия населенностей Δ : для рис. (а) между ___ и ___; для рис. (б) между ___ и ___

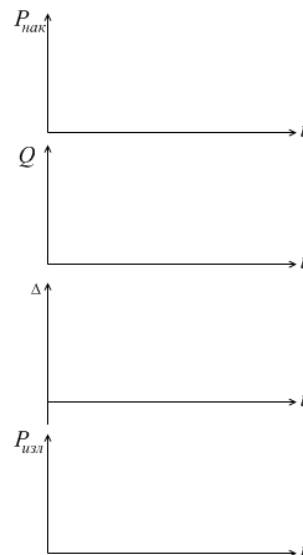
3) Обозначьте метастабильные уровни на рисунках а) и б) звездочками.

Пример варианта тестового задания по учебному материалу 2-го модуля курса

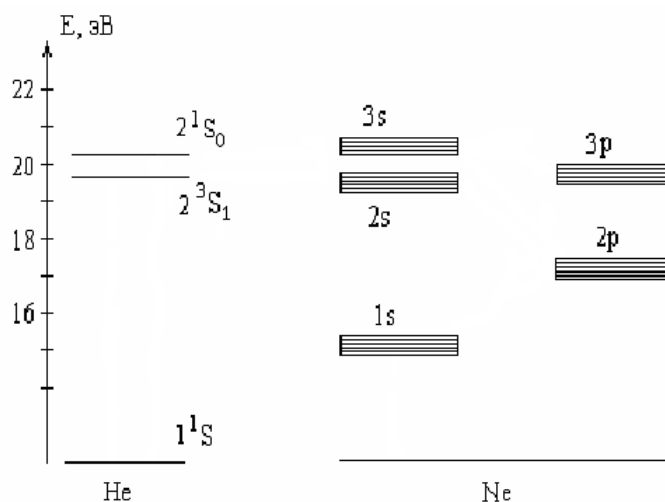
1. Нарисуйте:

оптическую схему твердотельного лазера в режиме модулированной добротности и графики, поясняющие формирование импульса излучения лазера :

- форму импульса накачки $P_{нак}(t)$;
- добротность резонатора $Q(t)$;
- инверсии населенностей $\Delta(t)$,
- мощности выходного излучения лазера $P_{изл}(t)$.



2. На рисунке приведена схема энергетических уровней атомов гелия и неона, используемых в гелий – неоновом лазере. Используя рисунок, поясните механизмы накачки и каналы генерации в этом лазере в процессе газового разряда в трубке с газом Нарисуйте устройство газового лазера.



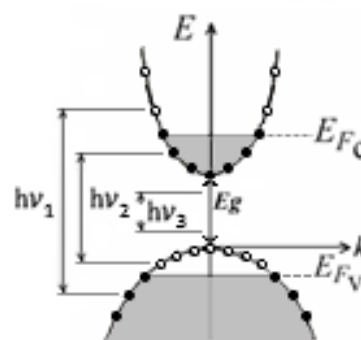
3. На рисунке показана структура энергетических уровней вырожденного прямозонного полупроводника, т.е. зависимость энергии $E(k)$, соответственно в зоне проводимости и валентной зоне, и положение квазиуровней Ферми E_{FV} и E_{FC}

На полупроводник воздействует свет с частотой ν

Проанализируйте процесс взаимодействия света с полупроводником

для случаев: а) $\nu = \nu_1$ б) $\nu = \nu_2$ в) $\nu = \nu_3$

Напишите, как следствие этого анализа, условие усиления волны в полупроводнике.



дважды

образом

световой

Критерии оценки тестового задания

Каждое тестовое задание состоит из 3-х вопросов.

Ответ на один вопрос оценивается максимально 5-ью баллами.

5 баллов выставляется студенту, если дан правильный и полный ответ;

4 балла выставляется студенту, если в целом дан правильный ответ, однако имеются несущественные ошибки;

3 балла выставляется студенту, если в ответе отсутствуют принципиальные положения, характеризующие физические процессы или устройство;

1-2 балла выставляется студенту, если в ответе освещается только часть вопроса или дан ошибочный ответ;

0 балла выставляется студенту при отсутствии ответа.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Акманов А.Г., Шакиров Б.Г. Основы квантовых и оптоэлектронных приборов: учебное пособие. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013 (количество экз.-38)

2. Айрапетян В.С., Ушаков О.К. Физика лазеров: учебное пособие. - Новосибирск: СГГА, 2012 (электронная версия печ. публикации).
3. Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства [Электронный ресурс]: методические указания / БашГУ; сост. А. Г. Акманов, Б. Г. Шакиров. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. — Электрон. версия печ. публикации. — Доступ возможен через Электронную библиотеку БашГУ. — <URL:<https://elib.bashedu.ru/dl/corp/AkmanovShakirovSost.Optoelektr.iKvantovyePriboryUstr.Met.Uk.pdf>>.

Дополнительная литература

1. Звелто О. Принципы лазеров. - М: Мир, издания 1979, 1984, 1990, 2008 (количество экз.-7)
2. Ярив А. Введение в оптическую электронику. - М.: ВШ, 1983 (кол. экз.-6)
3. Качмарек Ф. Введение в физику лазеров. - М: 1981 (кол. экз.-4)

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

1. Учебные пособия, справочные издания и статьи в ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по направлениям: Квантовая электроника, Оптоэлектроника, Нелинейная оптика.

2. Электронные ресурсы библиотеки Башкирского государственного университета:

1. Электронная библиотечная система. ЭБ БашГУ	Собственная электронная библиотека учебных и научных электронных изданий, которая включает издания преподавателей БашГУ	Авторизованный доступ по паролю из любой точки сети Интернет	Регистрация в библиотеке БашГУ, дальнейший доступ из любой точки сети Интернет	https://elib.bashedu.ru
2. Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн.	Полнотекстовая БД учебных и научных электронных изданий	Авторизованный доступ по паролю из любой точки сети Интернет	Регистрация в библиотеке БашГУ, дальнейший доступ из любой точки сети Интернет	https://www.biblioclub.ru
3. Электронно-библиотечная система издательства Лань.	Полнотекстовая БД учебных и научных электронных изданий	Авторизованный доступ по паролю из любой точки сети Интернет	Регистрация в библиотеке БашГУ, дальнейший доступ из любой точки сети Интернет	https://e.lanbook.com/
4. Электронный каталог Библиотеки БашГУ	Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Включает в себя систему каталогов и картотек, справочно-библиографический фонд.	Авторизованный доступ по паролю из любой точки сети Интернет	Регистрация в библиотеке БашГУ, дальнейший доступ из любой точки сети Интернет	https://www.bashlib.ru/catalog/

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекционных занятий используется аудиторный фонд физико-технического института.

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практики в соответствии с учебным планом	Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность учебных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения (позволяющего проводить компьютерное тестирование, онлайн-курсы). Реквизиты подтверждающего документа
	2	3	4	5
1	<p>Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства</p>	<p>1. Учебные аудитории для проведения учебных занятий: Аудитория №415 Аудитория №317 Лаборатория квантовой электроники</p> <p>2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и электронную информационно-образовательную среду организации: Читальный зал №2</p>	<p>Аудитория №415 Оборудование: доска, учебная мебель, проектор</p> <p>Аудитория №317 Лаборатория квантовой электроники Оборудование: учебная мебель, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 Samsung, кресло Manager, системный блок компьютера P 166 MMX, системный блок компьютера P 166 MMX, монитор Samsung 4006, монитор Samsung 4006 Монитор Samsung 4006 Генераторы сигналов: ГЗ-109, ГЗ-112/1, ГЗ-118, GFG-82191; Осциллографы: С1-93, С1-83 -2 шт; Источники питания: ВИП 009, НУ1803D, НУ3003; Макеты к лабораторным работам №1-№5 анализатор спектра - 1 шт., электроизмерительные приборы – 4 шт.</p> <p>Читальный зал №2 Оборудование: научный и учебный фонд, научная периодика, неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество посадочных мест – 50, ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети Интернет, неограниченный доступ к электронным БД и ЭБС; количество посадочных мест – 8</p>	<p>Лицензионное программное обеспечение: 1. Windows 8 Russian; Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор №104 от 17.06.2013 г. Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная. 2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор №114 от 12.11.2014 г.. Лицензия- OLP NL Academic Edition. Бессрочная.</p> <p>Лицензионное программное обеспечение, позволяющее проводить компьютерное тестирование: 1. Moodle «Официальный оригинальный английский текст лицензии для системы Moodle - http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> Перевод лицензии для системы Moodle - http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf></p>

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
 ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства, 6 семестр
 (наименование дисциплины)

очная

форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4 /144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	65,2
лекций	32
практических/ семинарских	
лабораторных	32
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	42,8
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету дифференцированному зачету (Контроль)	36

Форма контроля: экзамен - 6-й семестр, контактных часов – 65,7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства, 6 семестр
(наименование дисциплины)

заочная

форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	5 /180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	20
лекций	8
практических/ семинарских	
лабораторных	10
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,7
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	153
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету дифференцированному зачету (Контроль)	7,8

Форма контроля: экзамен - 8-й семестр

Очная форма обучения

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Модуль 1: Физические основы квантовой электроники Введение. Квантовые приборы-мазер и лазер. Оптоэлектронные приборы. Применение лазеров и оптоэлектронных приборов в системах оптической связи. Взаимодействие электромагнитного излучения(света) с веществом. Энергетические состояния квантовой системы. Населенности квантовых уровней. Квантовые переходы в двухуровневой модели атома: спонтанные и вынужденные переходы. Вероятности квантовых переходов, коэффициенты Эйнштейна. Резонансное поглощение, спонтанное и индуцированное излучения, их свойства.</p>	2			6	<p>[1] 1.1,1.2, 2.1-2.3. [3] 1.1-1.5,1.7</p>	<p>[д.1].2. 2,2.3, 2.4.3 [д.3] гл.1.гл.2</p>	

	<p>Связь между коэффициентами Эйнштейна</p> <p>Физические принципы действия оптических квантовых усилителей и квантовых генераторов- (лазеров): вынужденное излучение, инверсия населенностей квантовых уровней, положительная обратная связь. Коэффициент квантового усиления. Оптическая схема лазера. Условие самовозбуждения лазера. Методы инверсии населенностей квантовых уровней. Метод вспомогательного излучения, электрическая накачка. Метод оптической накачки. Трех- и четырех-уровневые схемы накачки. Кинетические уравнения для населенностей уровней.</p> <p>Пассивные оптические резонаторы. Открытый резонатор (ОР) как колебательная система в оптическом диапазоне. Параметры открытых резонаторов, их классификация. Добротность ОР. Геометрическая, волновая и дифракционная теории открытого резонатора. Спектр продольных и поперечных мод ОР.</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>2</p>			<p>6</p> <p>8</p>	<p>[1] .2.4,2.5</p> <p>[3] 2.1</p> <p>[1] .2.6,2.7</p> <p>[3] 2.2.1</p> <p>[1] .2.9,2.10</p> <p>[3] 2.3.1-2.3.3</p>	<p>[д1] 3.2</p> <p>[д.1] 4.1</p> <p>[д.3] гл.7</p>	<p>Отчеты по лабораторным работам</p> <p>Тестирование по учебному материалу 1-го модуля</p>
--	--	----------------------------	--	--	-------------------	---	--	---

2	<p>Модуль2: Приборы и устройства квантовой электроники и оптоэлектроники</p> <p>Твердотельные лазеры. Конструкция, составные части лазера- активные элементы, зеркала, лампы накачки. Лазер на рубине, неодимо- вые лазеры. Схемы электропитания твердотельных лазеров. Импульсные режимы ра- боты твердотельных лазеров. Свободная генерация, оптическая схема лазера, динамика формирования импульсов излучения. Режим модулированной добротности резонатора лазера: оптико-меха- нический, электрооптичес- кий и пассивный методы модуляции добротности. Режим синхронизации мод.</p> <p>Газовые лазеры. Механизмы создания инверсии населен- ностей в плазме газового разряда. Атомные, молеку- лярные и ионные газовые лазеры. Гелий-неоновый, аргоновый лазеры, лазер на молекулах CO₂</p>	6		16	10	<p>[1] 3.1-3.5 [д2] [4]</p> <p>[2] глава 2</p> <p>[1] 3.6 [3] гл.4</p> <p>[1] 4.1-4.4 [2] глава 3.</p>	<p>[д 1] 6.2 [д 2] 7.2,7.3 [д.3] гл.6</p> <p>[д 1] 6.3 [д 2] 7.5,7.6 [д 3] 8.1-8.2</p>	<p>Отчеты по лабораторным работам</p> <p>Тестирование по учебному материалу 2-го модуля</p>
---	--	---	--	----	----	--	--	---

<p>Полупроводниковые лазеры. Процессы в р-п переходе полупроводника. Условие квантового усиления света в полупроводнике. Лазер на кристалле GaAs на гомо-переходе, конструкция, характеристики, его недостатки. Конструкция и принцип действия полупроводникового лазера на двойном гетеропереходе. Характеристики выходного излучения, преимущества таких лазеров. Свойства лазерных пучков. Монохроматичность лазерного излучения. Основы теории и формы линии излучения. Естественное, столкновительное и доплеровское уширение линии излучения. Управление шириной спектра генерации лазера. Когерентность лазерного излучения. Пространственная и временная когерентность, методы ее измерения. Пространственные характеристики лазерного пучка. Расходимость, распределение интенсивности лазерного излучения в сечении пучка. Одномодовый и многомодовый режимы генерации.</p> <p>Нелинейная оптика.</p>	4		8	10	[1] 5.1-5.6 [2] глава4. [4]	[д 2] 7.8 [д 3] 13.1, 2	Тестирование по учебному материалу 2-го модуля
	2			6	[4] [1] 6.1-6.4 [3] гл.3	[д1]6.6 [д.3] гл.5.гл.2	
	2				[2] 1.11.5		

	Генерация оптических гармоник излучения лазеров, самофокусировка , вынужденное рассеяние света. Применение лазеров	4		8	8	[1] 7.1-7.5; [2] глава7.	[д3] 17.1-5	
	Оптоэлектроника. Принцип действия полупроводниковых фотоприемников оптического излучения. Фотодиоды,схемы включения,характеристики.	2			8	[3] гл.5 [2] 8.8, 8.9, 8.15,8.16.		Экзамен
...								
	Всего часов:	32		32	62			53

Заочная форма обучения

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Модуль 1: Физические основы квантовой электроники Введение. Квантовые приборы-мазер и лазер. Оптоэлектронные приборы. Применение лазеров и оптоэлектронных приборов в системах оптической связи. Взаимодействие электромагнитного излучения(света) с веществом. Энергетические состояния квантовой системы. Населенности квантовых уровней. Квантовые переходы в двухуровневой модели атома: спонтанные и вынужденные переходы. Вероятности квантовых переходов, коэффициенты Эйнштейна. Резонансное поглощение, спонтанное и индуцированное излучения, их свойства.</p>	1			6	<p>[1] 1.1,1.2; 2.1-2.3. [3]1.1-1.5,1.7</p>	<p>[д1] 2.2,2.3,2.4.3 [д3]гл.1,гл.2</p>	

	<p>Связь между коэффициентами Эйнштейна</p> <p>Физические принципы действия оптических квантовых усилителей и квантовых генераторов- (лазеров): вынужденное излучение, инверсия населенностей квантовых уровней, положительная обратная связь. Коэффициент квантового усиления. Оптическая схема лазера. Условие самовозбуждения лазера. Методы инверсии населенностей квантовых уровней. Метод вспомогательного излучения, электрическая накачка. Метод оптической накачки. Трех- и четырех-уровневые схемы накачки. Кинетические уравнения для населенностей уровней.</p> <p>Пассивные оптические резонаторы. Открытый резонатор (ОР) как колебательная система в оптическом диапазоне. Параметры открытых резонаторов, их классификация. Добротность ОР. Геометрическая, волновая и дифракционная теории открытого резонатора. Спектр продольных и поперечных мод ОР.</p>	1			6	<p>[1] .2.4,2.5;</p> <p>[3]2.1</p> <p>;</p> <p>[1] .2.6 ,2.7;</p> <p>[3]2.2.1</p>	[д 1] 3.2	
		1		8		<p>[1] 2.9, 2.10;</p> <p>[3]2.3.1-2.3.3</p>	<p>[д1] 4.1.</p> <p>[д3] гл.7</p>	

2	<p>Модуль2: Приборы и устройства квантовой электроники и оптоэлектроники</p> <p>Твердотельные лазеры. Конструкция, составные части лазера- активные элементы, зеркала, лампы накачки. Лазер на рубине, неодимо- вые лазеры. Схемы электропитания твердотельных лазеров. Импульсные режимы ра- боты твердотельных лазеров. Свободная генерация, оптическая схема лазера, динамика формирования импульсов излучения. Режим модулированной добротности резонатора лазера: оптико-меха- нический, электрооптичес- кий и пассивный методы модуляции добротности. Режим синхронизации мод.</p> <p>Газовые лазеры. Механизмы создания инверсии населен- ностей в плазме газового разряда. Атомные, молеку- лярные и ионные газовые лазеры. Гелий-неоновый,</p>	2	4	10	<p>[1] 3.1-3.5 [д2]</p> <p>[2] гл.2</p> <p>[1] 3.6</p> <p>[3] гл.4</p> <p>[1] 4.1-4.4</p>	<p>[д 1] 6.2</p> <p>[д 2] 7.2,7.3</p> <p>[д3]гл.6</p> <p>[д 1]6.3 [д 2] 7.5,7.6 [д 3] 8.1-8.2,</p>		

<p>аргоновый лазеры, лазер на молекулах CO₂</p> <p>Полупроводниковые лазеры. Процессы в р-п переходе полупроводника. Условие квантового усиления света в полупроводнике. Лазер на кристалле GaAs на гомо-переходе, конструкция, характеристики, его недостатки. Конструкция и принцип действия полупроводникового лазера на двойном гетеропереходе. Характеристики выходного излучения, преимущества таких лазеров.</p> <p>Свойства лазерных пучков. Монохроматичность лазерного излучения. Основы теории и формы линии излучения. Естественное, столкновительное и доплеровское уширение линии излучения. Управление шириной спектра генерации лазера.</p> <p>Когерентность лазерного излучения. Пространственная и временная когерентность, методы ее измерения.</p> <p>Пространственные характеристики лазерного пучка. Расходимость, методы ее измерения. Распределение интенсивности лазерного излучения в сечении пучка.</p>	1		4	8	<p>[1] 5.1-5.6</p> <p>[2] гл.4</p> <p>[4]</p> <p>[4]</p> <p>[1] 6.1-6.4</p> <p>[3] гл.3</p> <p>[2] 7.2, 7.5, 7.6, 7.9.</p>	<p>[д 2] 7.8</p> <p>[д 3] 13.1, 2</p> <p>[д 1] 6.6</p> <p>[д3] гл.2, гл.5</p>	
---	---	--	---	---	--	---	--

	<p>Одномодовый и многомодовый режимы генерации.</p> <p>Нелинейная оптика. Генерация оптических гармоник излучения лазеров, самофокусировка, вынужденное рассеяние света. Применение лазеров</p> <p>Оптоэлектроника. Принцип действия полупроводниковых фотоприемников оптического излучения. Фотодиоды, схемы включения, характеристики.</p>	1		2	4	<p>[1] 7.1-7.5;</p> <p>[3] гл.7</p> <p>[2] 8.8, 8.9, 8.15-16</p>	<p>[д3] 17.1-5.</p> <p>[д1] гл.17</p>	<p>Контрольная работа</p> <p>Экзамен</p>
...								
	Всего часов:	8		10	153			7,8

Рейтинг-план дисциплины
Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства
(название дисциплины согласно рабочему учебному плану)

Направление Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Курс 3 , семестр 2

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Модуль 1: Физические основы квантовой электроники			0	34
Текущий контроль				
1.Выполнение лабораторной работы, составление и сдача отчета	7	2	0	14
2. Тестирование	5	1	0	5
Рубежный контроль				
1. Письменный опрос	15	1	0	15
Модуль2: Приборы и устройства квантовой электроники			0	36
Текущий контроль				
1.Выполнение лабораторной работы, составление и сдача отчета	7	3	0	21
Рубежный контроль				
1. Письменный опрос	15	1	0	15
Поощрительные баллы				
1.Участие в конференциях, публикация статей	10	1	0	10
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
1.Посещение лекционных занятий			0	-6
2.Посещение практических занятий			0	-10
Итоговый контроль				
1. Экзамен				30

Форма экзаменационного билета

Минобрнауки России
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет

Физико-технический институт
Кафедра инфокоммуникационных технологий и наноэлектроники


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства
Направление 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Профиль Оптические системы и сети связи

1. Взаимодействие света с веществом, Спонтанные и индуцированные переходы в квантовых системах. Вероятности квантовых переходов. Коэффициенты Эйнштейна.

2. Открытые резонаторы. Спектр собственных частот открытого резонатора. Стоячая волна.

Заведующий кафедрой



_____ / Салихов Р.Б. /